

SOT-23



Pin Definition:

1. Gate
2. Source
3. Drain

Key Parameter Performance

Parameter	Value	Unit
V_{DS}	100	V
$R_{DS(on)}$ (max)	250	m Ω
Q_g	11.1	nC

Features

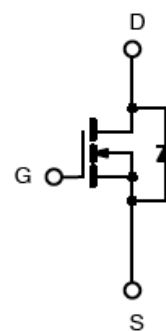
- Low $R_{DS(ON)}$ 250m Ω (Max.)
- Low gate charge typical @ 11.1nC (Typ.)
- High performance trench technology

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TSM2328CX RFG	SOT-23	3Kpcs / 7" Reel

Note: "G" denotes for Halogen- and Antimony-free as those which contain <900ppm bromine, <900ppm chlorine (<1500ppm total Br + Cl) and <1000ppm antimony compounds

Block Diagram



N-Channel MOSFET

Absolute Maximum Rating ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	100	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Continuous Drain Current	I_D	1.5	A
Pulsed Drain Current ^(Note 1)	I_{DM}	6	A
Continuous Source Current (Diode Conduction)	I_S	0.6	A
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	1.38	W
Operating Junction Temperature	T_J	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

Thermal Performance

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Thermal Resistance - Junction to Foot	$R_{\theta_{JF}}$	55	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance - Junction to Ambient	$R_{\theta_{JA}}$	100	$^\circ\text{C/W}$

Electrical Specifications (T_J=25°C unless otherwise noted)

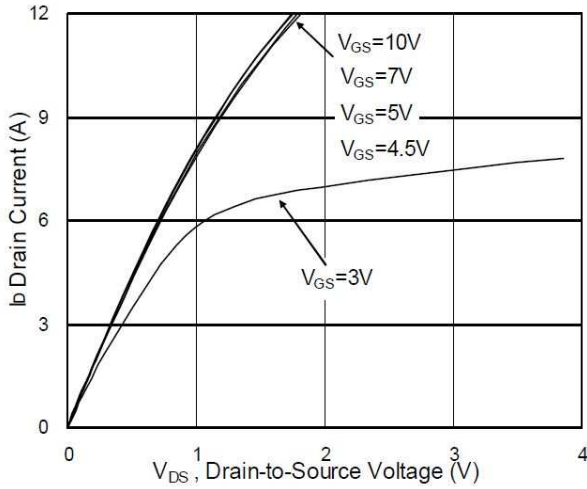
Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0V, I _D = 250μA	BV _{DSS}	100	--	--	V
Drain-Source On-State Resistance	V _{GS} = 10V, I _D = 1.5A	R _{DS(ON)}	--	--	250	mΩ
Gate Threshold Voltage	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250μA	V _{GS(TH)}	1.0	--	2.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 80V, V _{GS} = 0V	I _{DSS}	--	--	1	μA
Gate Body Leakage	V _{GS} = ±20V, V _{DS} = 0V	I _{GSS}	--	--	±100	nA
On-State Drain Current	V _{DS} = 5V, V _{GS} = 10V	I _{D(ON)}	6	--	--	A
Forward Transfer Conductance	V _{DS} = 15V, I _D = 1.5A	g _{fs}	--	4	--	S
Diode Forward Voltage	I _S = 1A, V _{GS} = 0V	V _{SD}	--	1.2	--	V
Dynamic (Note 2)						
Total Gate Charge	V _{DS} = 80V, I _D = 1.5A, V _{GS} = 5V	Q _g	--	11.1	--	nC
Gate-Source Charge		Q _{gs}	--	4.4	--	
Gate-Drain Charge		Q _{gd}	--	3	--	
Input Capacitance	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1.0MHz	C _{iss}	--	975	--	pF
Output Capacitance		C _{oss}	--	38	--	
Reverse Transfer Capacitance		C _{rss}	--	27	--	
Switching (Note 3)						
Turn-On Delay Time	V _{DD} = 30V, I _D = 1A, V _{GEN} = 10V, R _L = 30Ω, R _G = 6Ω	t _{d(on)}	--	9	--	ns
Turn-On Rise Time		t _r	--	9.4	--	
Turn-Off Delay Time		t _{d(off)}	--	26.8	--	
Turn-Off Fall Time		t _f	--	2.6	--	

Note:

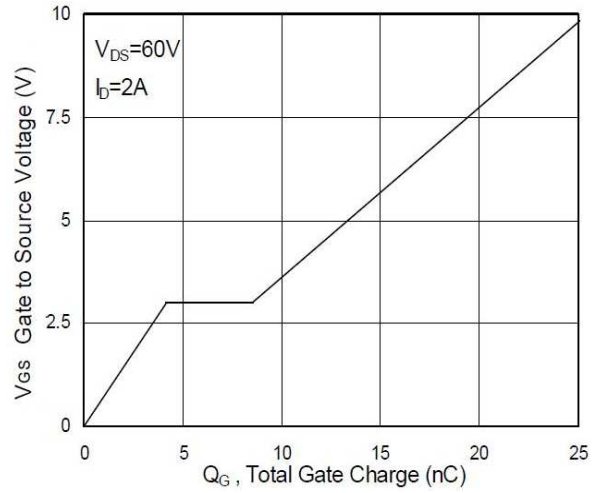
- Limited by maximum junction temperature.
- Pulse test: pulse width ≤300μs, duty cycle ≤2%.
- Guaranteed by design, not subject to production testing

Electrical Characteristics Curve

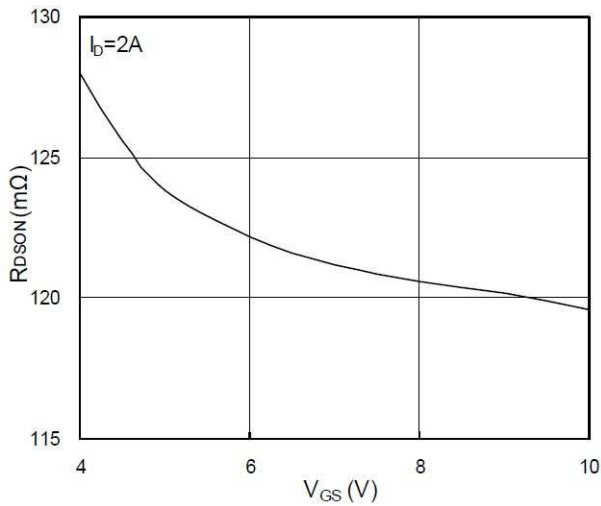
Typical Output Characteristic



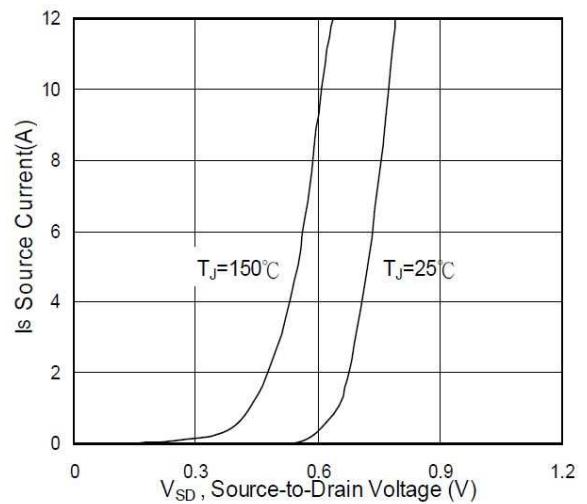
Gate Charge



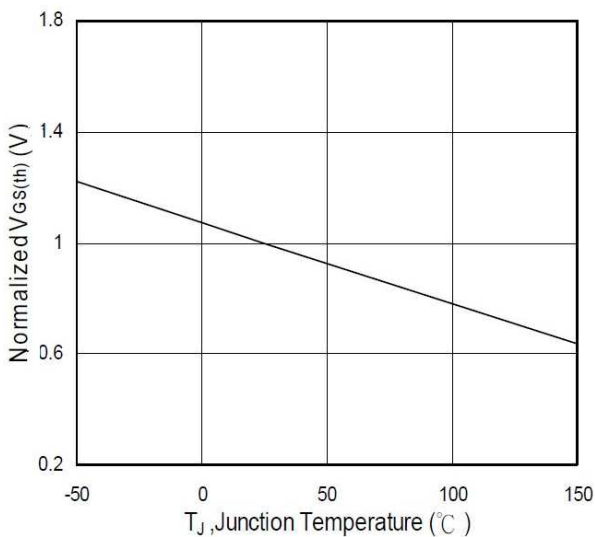
On-Resistance vs. Gate-Source Voltage



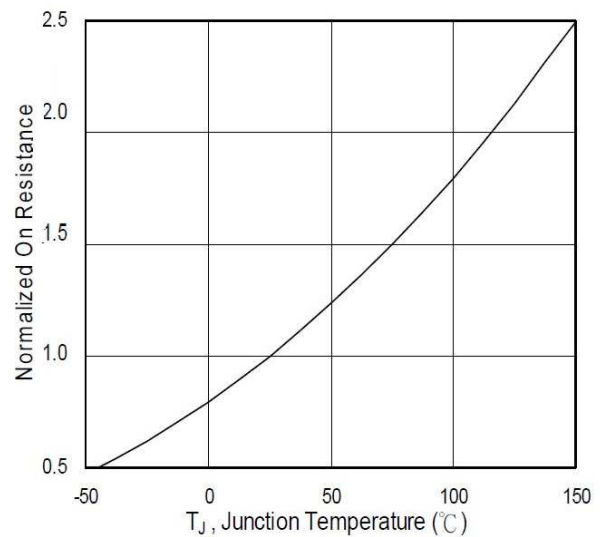
Source-Drain Diode Forward Voltage



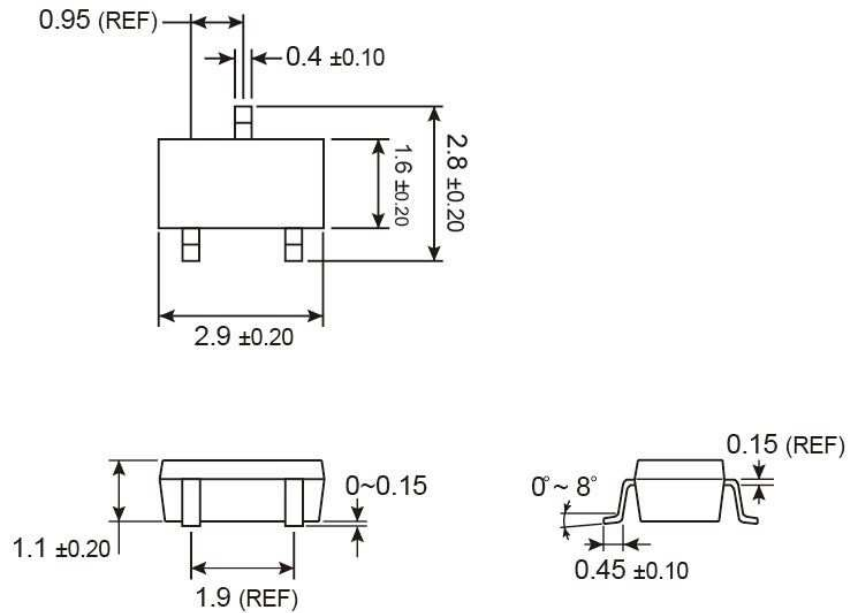
Normalized $V_{GS(th)}$ vs. Junction Temperature



Normalized $R_{DS(on)}$ vs. Junction Temperature

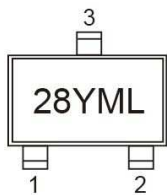


SOT-23 Mechanical Drawing



Unit: Millimeters

Marking Diagram



- Y** = Year Code
- M** = Month Code for Halogen Free Product
(**O**=Jan, **P**=Feb, **Q**=Mar, **R**=Apr, **S**=May, **T**=Jun, **U**=Jul, **V**=Aug, **W**=Sep, **X**=Oct, **Y**=Nov, **Z**=Dec)
- L** = Lot Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.